PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-265087

(43) Date of publication of application: 26.09.2000

(51)Int.CI.

C09D 5/24 C25D 7/00 G03F 7/038 G03F 7/30 H01J 9/20 H01J 11/02 H05K 9/00

(21)Application number: 11-109882

(71)Applicant: MIKUNI COLOR LTD

(22)Date of filing:

11.03.1999

(72)Inventor: YAMAWAKI KAZUMASA

ARATA SATORU

KADOWAKI TETSUHARU

(54) METHOD FOR FORMING METAL PATTERN

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prepare a light-transmitting electromagnetic-wave shielding material at a low cost at a high productivity by a simple and convenient method by forming a pattern on a substantially transparent substrate from a conductive ink having a specified surface resistance at a specified film thickness.

SOLUTION: After a pattern is formed on a transparent substrate from a conductive ink having a surface resistance of $1.0 \times 103~\Omega/(\text{square})$ or lower at a film thickness of $15~\mu\text{m}$, a negative photoresist layer with a thickness larger than that of the pattern is formed. Then, the pattern comprising the conductive ink is masked from the back side of the substrate having the photoresist layer and all the front side is exposed to light. After all the parts of the photoresist layer other than parts having the pattern formed thereon are cured, only the photoresist on the pattern comprising the conductive ink is developed and removed. Then, a metal pattern is formed by electrolytic plating on only the pattern comprising the conductive ink by using the cured resist as a plating—resistant resist.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-265087 (P2000-265087A)

(43)公開日 平成12年9月26日(2000.9.26)

		酸別記号			(10) 21	/U H	T MATE + 5 /120 H (2000. 5. 20)			
(51) Int.Cl.7			F I '						;	テーマコード(参考)
C09D	5/24		C091)	5/24					2H025
C 2 5 D	7/00		C 2 5 I)	7/00				G	2H096
G03F	7/038		G 0 3 F	7	7/038					4 J O 3 8
	7/30				7/30					4 K 0 2 4
H01J	9/20		H01J	r	9/20				Α	5 C O 2 8
	<u> </u>	審査請求	未請求。諸	·坎	頁の数1	書面	(全	6	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平 11-109882	(71)出版	質人	591064	508				
					御国色	素株式	会社			
(22)出願日		平成11年3月11日(1999.3.11)	兵庫県姫路市御国野町国分寺138-1							
			(72)発明	月者	山脇	一正				
		•	,		兵庫県	姫路市	御国野	野町	「国分	寺138-1 御
					国色素	株式会	社内			
			(72)発明	用者	安良田	悟				
					兵庫県	姫路市	御国里	爭町	国分	寺138-1 御
		•			国色素	株式会	社内			•
			(72)発明	猪	門脇	散治				
					兵庫県	姫路市	御国里	抒町	国分	寺138-1 御
					国色素	株式会	社内			
					-					最終頁に続く
		•	1							

(54) 【発明の名称】 金属パターン形成方法

(57)【要約】

【目的】 本発明は、基体上に高解像性の金属メッキバターンを安価に生産性良く作製することを目的とする。 【構成】 本発明の目的は、実質的に透明な基体上に、 導電性インクを用いて、バターンを形成させた後、該透明基体上に、ネガタイプのフォトレジスト層を該バターンの膜厚より大なる状態で設け、その後、該層が設けられた透明基体の裏側から該導電性インクよりなるバターンをマスクにして全面露光し、該導電性インクよりなるバターン部上のフォトレジストのみを現像して除去する。その後、電解メッキ法により、該導電性インクよりなるバターン部成方法により達成される。特に、電子材料分野や建材分野等における光透過型の電磁波シールド部材の作製に有効である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 実質的に透明な基体上に、膜厚15μmで1.0×10° Q/□以下の表面抵抗を有する導電性インクを用いて、パターンを形成させた後、該透明基体上に、ネガタイプのフォトレジスト層を該パターンの膜厚より大なる状態で設け、その後、該層が設けられた透明基体の裏側から該導電性インクよりなるパターンをマスクにして全面露光し、該導電性インクよりなるパターンが設けられていないフォトレジスト部を硬化させた後、該導電性インクよりなるパターン部上のフォトレジストのみを現像して除去する。その後、電解メッキ法により、該硬化レジストを耐メッキレジストとして使用し、該導電性インクよりなるパターン上のみに金属パターンを形成させる金属パターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特に、電子材料分野や建材分野等における、光透過型の電磁波シールド部材を作製する上において有効な金属パターン形成方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】最近、微細金属バターン加工技術の応用として、プラズマディスプレイバネルの前面フィルタ用透明電磁波シールドフイルム作製への応用が提案されている。以下、該電磁波シールドフイルムを例に従来技術を説明する。

【0003】薄型、大画面テレビの実現に向けて、各種 のフラットディスプレイパネルが開発されており、その 中でも、特にプラズマディスプレイパネル(以下PD P) が注目されている。その理由は、現在主流のCRT 30 では困難な薄型やTFT液晶では困難な大画面化がPD Pでは容易に達成出来るからである。一方、PDPは、 プラズマ放電を利用しているため、CRTやTFTと比 較すると画面から放射される電磁波量が多く、VCCI 規制を満足することが難しい。画面から放射される電磁 波をシールドするには、前面フィルタに導電性層を形成 することが挙げられる。一方、電磁波シールド用フィル タは、PDP画面の前面に装着されるため透明性にも優 れていなければならない。その結果として、透明導電性 膜を使用する方法が提案されているが、この方法では、 透明性及び画質は優れているが、表面抵抗が金属にくら べると高いためシールド性が劣る結果となる。一方、ポ リエステル繊維に無電解メッキを施した導電性繊維メッ シュ方式では抵抗が低いためシールド性は優れている が、繊維径Φが40μm程度が限界であり、しかもライ ンピッチを粗くすることが製造プロセス上困難なため、 メッシュの開口率が低く透明性が劣るという欠点があ

【0004】とれらの、開口率と電磁波シールド性の両立という問題点を解決する方法として、銅箔を接着剤で 50

ボリエステルフィルムに貼り付けたフィルム銅箔上に、 レジストフィルムを貼り付け、露光、現像、銅のケミカ ルエッチング、レジスト剥離のフォトリソグラフィー工 程により、該基材上にライン巾が狭く、ラインピッチ間 が広い銅メッシュを形成させ、それを熱接着剤を介して 透明基板と熱圧着させた電磁波シールド材が提案されて いる

【0005】この方法は、フォトリソグラフィー法による微細加工を利用しているため、開口率と電磁波シールド性の両立という観点で、従来法に比べて優れた方法である。しかしながら、この方法にしてもトータル原材料のコスト高、及び生産効率の悪さによるコスト高という問題点を抱えている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の開口率と電磁波シールド性を両立する微細加工された銅メッシュ電磁波シールド材を生産性の優れた簡便な方法で安価に作製するととを目的にしたものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の課題は、実質的に透明な基体上に、膜厚15μmで1.0×10° Ω/□以下の表面抵抗を有する導電性インクを用いて、パターンを形成させた後、該透明基体上に、ネガタイプのフォトレジスト層を該バターンの膜厚より大なる状態で設け、その後、該層が設けられた透明基体の裏側から該導電性インクよりなるパターンが設けられていないフォトレジスト部を硬化させた後、該導電性インクよりなるパターンが設けられていないフォトレジスト部を硬化させた後、該導電性インクよりなるパターン部上のフォトレジストのみを現像して除去する。その後、電解メッキ法により、該硬化レジストを耐メッキレジストとして使用し、該導電性インクよりなるパターン上のみに金属パターンを形成させる金属パターン形成方法により達成される。

[0008]

「発明の実施の形態」以下、本発明を詳細に説明する。本発明において、実質的に透明な基体という言葉の「実質的に透明」という意味は、裏面露光に際して、該レジストの分光感度波長の光を透過できるという意味である。該実質的に透明な基体の例としては、ガラス基板、40 PET、PEN、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリイミド、PP、PE、塩ビ樹脂、セルロースエステル、ブチラール樹脂フイルム(あるいは板)など上記の定義を満たすものであれば種々のフイルムや基板の使用が可能であり、又着色されていてもさしつかえない。又、これら基体上には、導電性インクやフォトレジストとの密着を向上させることを目的に下塗り層やコロナ処理やグロー処理などの表面処理を必要に応じて行ってもよい。又、該基体の裏面には、必要に応じて、耐傷性を目的にハードコート層等を設けてもよい。

【0009】本発明の実質的に透明な基体上に金属メッ

キパターン設ける応用例として、PDP用透明電磁波シ ールドフィルムを例にして説明すれば、前述したごと く、高い開口率と導電性が必要である。そのためには、 メッシュライン巾が狭く、ラインピッチ巾が広い、髙導 電性のメッシュパターンが必要とされる。例えば日立化 成テクニカルレポートNo.32(1999-1)P2 1~24には前述の銅箔エッチング法による電磁波シー ルドフイルム作製方法において、銅メッシュのライン巾 (μm) 及びラインピッチ巾(μm) と開口率 (%) 及 びシールド性(dB)の関係が述べられいる。その結果 10 として、ライン巾20µm、ラインピッチ250µm、 導体銅膜厚12μmの銅メッシュ仕様で、1~1000 MHzの領域でシールド性50dB、可視光透過率72 %の高性能が得られるとしている。この結果はVCC 1 クラスBを取得できる値である。そして、この理由は銅 の体積固有抵抗が6. 2×10^{- 0} Ω c m程度と非常に 導電性が高いことに由来する。

【0010】本発明は、実質的に透明な基体上に、導電 性インクを用いて、パターンを形成させた後、該透明基 体上に、ネガタイプのフォトレジスト層を該バターンの 20 膜厚より大なる状態で設け、その後、該層が設けられた 透明基体の裏側から該導電性インクよりなるパターンを マスクにして全面露光し、該導電性インクよりなるパタ ーンが設けられていないフォトレジスト部を硬化させた 後、該導電性インクよりなるパターン部上のフォトレジ ストのみを現像して除去する。その後、電解メッキ法に より、該導電性インクよりなるパターン上のみに金属パ ターンを形成させる方法である。それゆえ、本発明の方 式により、金属メッシュ法透明電磁波シールド部材を作 製するための技術的ポイントは、電解メッキが可能な表 面抵抗を有する導電性インクを、ライン巾が狭い状態で メッシュパターンを形成することである。何故ならば、 本発明の方法によれば、導電性インクパターンの機能の ひとつであるマスク機能を有する該導電性インクバター ンとフォトレジストが接していることにより、裏面から の全面露光、その後の現像に際しても、硬化レジストの 高解像性及び良好なレジストプロファイル性が期待でき ること、そして、その耐メッキレジストを基にして電解 メッキをおこなうために、該導電性インクパターン上に 良好な解像性とプロファイル性を有する金属メッキバタ 40 ーンの形成が期待されることによる。

【0011】本発明者は、先ず、種々の公知の導電性インクを用いて、電解メッキが可能な表面抵抗は幾らであるかを調べた。その結果として、導電性インク層の表面抵抗が 1.0×10^8 Ω / \square 以下であれば、電解メッキ法により、種々の金属メッキが可能であることを確認した。一方、表面抵抗の値は、導電性インクの膜厚に依存する。

【0012】導電性インクのメッシュパターン形成方法としては、グラビア印刷やスクリーン印刷等の印刷法、

あるいは、導電性インクに感光性を持たせることによる フォトリソ法等があるが、安価に多量生産可能な方法と しては、印刷法によるメッシュパターン形成法が好まし い。特に基体がプラスっチックフィルムである場合には **量産性の観点から、グラビア印刷方式を利用して導電性** メッシュパターンを形成させることが特に好ましい。し かしながら、特に、メッシュ方式透明電磁波シールド部 材のごとく、例えば、ライン巾が20~30μmと狭い 高解像力パターンを印刷法で形成しようとした場合、所 定の表面抵抗を得るために、インク膜厚が厚い場合には ライン巾の狭い高解像力パターンが得られ難い。そのた めには、インク層の乾燥膜厚が15µm以下、特に1~ 10μmが好ましい。これ以下であると、導電性インク 層とメッキ金属層の間に応力が働き基体との密着性が損 なわれる場合がある。但し、本発明の金属パターン形成 法を、例えばプリント回路配線パターンのごとくライン 巾が広い系に利用する場合には15μm以下である必要 がない事は当然のことである。

【0013】一方、前述したどとく、導電性インク層の表面抵抗は該インク層の膜厚に依存する。例えば、10 2 Ω / \square オーダーの表面抵抗(Ω / \square)を10 μ m以下の膜厚で得ようとする場合には、体積固有抵抗が10 2 Ω c mオーダーの導電性インクを使用することが必要であろう。

【0014】一方、導電性インクは、一般に導電性材料として、例えば銀、ニッケル、銅、錫、ステンレス等の微粒子金属粉、あるいは、導電性カーボンブラック、グラファイト等の非金属粉、あるいはアルミ粉の表面を銀等でメッキした微粒子複合型金属粉等が用いられており、これらの導電性材料を有機や無機のバインダーに分散された状態で提供されている。例えばこれらの多くはアチソン社からは提供されている。このうち、金属粉を用いた導電性インクは体積固有抵抗が10-%Qcmオーダーと導電性が高いという欠点を有する。一方、導電性カーボンブラックやグラファイト等を用いた導電性インクの場合、原材料コストは安く、分散性が良好であるが、体積固有抵抗が一般には10°~10-%Qcmオーダーと導電性が低い欠点を有する。

40 【0015】しかしながら、カーボン系導電性インクにおいても、最近は、特開平7-33883、特開平7-53813、特開平7-41609、特開平1-101373、特開昭62-88261、特開昭62-88260、特開昭64-56777、特開昭54-36343、特開昭62-199663、特開昭63-125580、特開平1-184901、特開平2-284968、特開平5-65366、号明細書等に述べられているどとく、導電性カーボンブラックとグラファイトの複合系をバインダ中に分散した導電性インクを用いることにより、体積固有抵抗が10-2Qcmオーダーの高導

30

電性が得られている。

【0016】後続のレジストバターン形成のための導電 性インクバターンの光遮蔽性という観点からは、金属粉 導電性インクであれ、カーボン系導電性インクであれ、 基本的には十分であるが、原材料コストの観点から導電 性カーボンブラックとグラファイトの複合系導電性イン ク材料を用いることが好ましい。カーボン複合型導電性 インクの高導電性は、一般に平板粒子のグラファイトに 3次元構造をもつカーボンを組み合わせることにより、 グラファイトの平板粒子相互のつながりを改善すること により発現されると考えられている。

【0017】導電性カーボンブラックとグラファイトの 複合型導電性インクに使用される導電性カーボンの具体 例としては、アセチレンブラック、ケッチェンブラッ ク、ファーネストブラック等従来公知の導電性カーボン の使用が可能であるが、導電性の観点から、ケッチェン ブラックが特に好ましい。勿論、カーボンブラック粒子 の表面を金属で被覆した複合粒子の使用も可能であるこ とはいうまでもない。また、グラファイトに関しては鱗 状黒鉛、土状黒鉛、膨張黒鉛、特殊処理黒鉛、▲か▼焼 コークス、薄片化粉末等の形で、日本黒鉛K. K. 、エ ス・イー・シーK. K. 、日立粉末冶金K. K. 、中越 黒鉛K. K. 等から各種のグラファイトが市販されてお り、いずれも使用可能であるが、鱗状黒鉛、薄片化黒 鉛、膨張黒鉛等の使用が特に好ましい。

【0018】本発明において使用される金属あるいは非 金属微粒子導電性材料を有する導電性インク組成物に配 合されるパインダーとしては、従来公知の各種の有機パ インダーや無機バインダーが使用される。

【0019】前記有機パインダーとしては、熱可塑性、 熱硬化性、電磁放射線硬化性のいずれでもよい。例え ば、ビニル系樹脂(塩ビ系樹脂、(メタ)アクリル酸エ ステル系樹脂、ピニリデン系樹脂、酢ビ系樹脂等)、ポ リエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、アクリロニトリル 系樹脂、フェノール樹脂、エポキシ系樹脂、ポリカーボ ネート、メラミン系樹脂、オレフィン系樹脂、ハロゲン 化ポリオレフィン、アセタール系樹脂、ポリイミド、ポ リスルフォン、ポリフェニレンオキサイド、セルロース 系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂等が挙げられ るがこれらに限定されるものではない。又、これらの樹 40 脂は水中に分散したエマルジョン形態で使用してもよ い。更に、とれらの組成中には熱硬化剤や光硬化剤等を 添加してもよい。

【0020】前記無機バインダーの例としては、シリ カ、酸化スズ、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、 ガラスフリット(鉛ホウケイ酸ガラス、ビスマスガラス 等)、従来公知のものの使用が可能であるが、これらに 限定されるものではない。これらの無機系バインダー は、一般に、導電性インクをパターン形成した後、該イ ンクを焼成することにより、髙硬度で耐擦過性に優れた 50 ガラス質の皮膜をつくることを目的とする場合やガラス 基板上に密着性の良好な導電性インク層を設けることを 目的とする場合に利用される。

【0021】本発明において、導電性インク組成物は、 通常水あるいは有機溶剤を使用するが、従来知られてい るどとく、電磁放射線硬化性導電性インク組成物のよう な場合には、バインダーとして液状の反応性オリゴマー 等を使用することにより、無溶剤化も可能である。

【0022】該有機溶剤としては、従来公知の溶剤が目 的に応じて使用可能である。例えば、炭化水素類(トル エン、キシレン等)、塩素化炭化水素類(メチクロ、エ チクロ、クロロベンゼン等)、エーテルアルコール類 (エトキシエタノール、メチルセロソルブ等)、エステ ル類(酢酸エステル等)、アルコール類(エタノール、 イソプロピルアルコール等)、ケトン類(シクロヘキサ ノン、メチルエチルケトン等、酸アミド類(ジメチルホ ルムアミド等)等が挙げられるが、これらに限定される ものではない。

【0023】前記カーボン系導電性インクを用いる場合 の、グラファイトと導電性カーボンとの配合割合は、重 **量比で1:9~9:1の範囲、更には4:6~8:2の** 範囲が好ましい。該カーボンの割合が前記範囲より多く なると抵抗が高くなる傾向が生じ、また少なくなっても グラファイト粒子間の繋がりが悪くなり、同じく抵抗が 高くなる傾向が生じる。

【0024】前記カーボン系導電性インクを用いる場合 のグラファイト及びカーボンの合計量とバインダーとの 配合割合としては、該導電剤の合計量/バインダーが重 量比で80/20~20/80、更には30/70~7 0/30の範囲が好ましい。この範囲より該導電剤の量 が少ない場合には所望の導電性が得られに難く、また多 すぎる場合には膜強度が弱くなる。又、金属系導電性イ ンクを用いる場合の配合比率も同じである。

【0025】また、前記溶剤の配合割合に関しては、塗 工する方法によりことなり、特に限定はないが、例え ば、大量生産向きのグラビア方式で印刷しバターン形成 をする場合には、インク粘度が10~100cpになる ように配合することが好ましい。又、スクリーン印刷方 式の場合には、10~1000 pが好ましい。

【0026】本発明において使用する導電性インク組成 物には、前記の他に必要に応じて、レベリング剤、可塑 剤、分散剤、沈降防止剤、滑剤、マット剤等を添加して もよい。また、本発明の導電性インク組成物は、前記成 分をボールミル、サンドミル、ビーズミル、2本ロー ル、ペイントシェーカー等の通常の分散機により均一に 分散させるととにより製造される。

【0027】本発明においては、導電性インクを用いて 前述した方法によりパターン形成した後、必要に応じ て、従来公知のどとく遠赤外線等により熱キュアさせ、 導電性インクパターンの導電性を更に向上させてもよ

【0028】該導電性インクを用いて、前述した方法に より、電磁波シールド部材作製の場合には、メッシュパ ターンを形成し、その後パターン形成した透明基板上に 光硬化タイプの感光性レジストをパターンの膜厚より大 なる状態で設ける。

【0029】光硬化タイプの感光性レジストとしては、 従来公知の種々のフォトポリマーが使用可能であるが、 本発明に使用される光硬化型フォトポリマーは、厚膜レ ジストであること、髙感度であるべきこと、耐メッキレ ジスト性があること、出来るだけ安価であること、等か ら光重合タイプのフォトポリマーを使用することが好ま しい。特にこれらの要件を満たすものとして、例えば、 「フォトポリマー・テクノロジー」(日刊工業新聞社発 刊、1988/12/30初版) P364-380、P 401-423に述べられている、プリント配線基板に 使用される光重合タイプの感光性樹脂が好ましい。との ようなフォトポリマーは、感光性ドライフイルムの形 で、あるいは、液状レジストの形で、溶剤現像タイプあ るいは炭酸ソーダ等のアルカリ水現像タイプとして、各 20 社から市販されているが、本発明の使用に際してはアル カリ水現像タイプのドライフイルムレジストあるいは液 状レジストを使用するのが好ましい。更に、メッキ用レ ジストとして利用されているものが特に好ましい。

【0030】該導電性インクパターンを有する該基板上 に、該導電性インクの膜厚より大なる状態で、該光硬化 タイプのフォトポリマーを設ける方法としては、ドライ フイルムレジストを使用する場合にはラミネート法によ り、また液状レジストを用いる場合には従来公知の種々 のコーティング法により設けることが出来る。後者の場 合は多量生産向きであり且つ導電性インクバターンへの 凹凸追従性がとくに良好である。また前者の場合は簡便 に作製するととが出来るのが特長であり、凹凸追従性が 問題となる場合には真空ラミネータを使用すればよい。

【0031】感光性レジストの膜厚に関しては、本発明 の金属パターン形成法を利用する対象により異なる。例 えば、電磁波シールド用に銅メッキをする場合は、メッ キ銅の膜厚は1~15μm程度でよいが、その場合レジ スト層の膜厚は、導電性インクの膜厚+必要とされる金 属メッキの膜厚のレジスト厚みが必要となる。また、プ 40 リント配線基板の配線パターンの場合には40μm程度 の銅膜厚を必要とする場合があるから、その場合にはレ ジスト膜厚は厚くなる。

【0032】とれらフォトレジスト中には、必要に応じ て紫外線吸収剤や色調調整のための色材や熱線カット剤 など種々の添加剤を添加してもよい。特に、PDP用電 磁波シールド部材として本発明を利用する場合には有効 である。

【0033】実質的に透明な基体上に、導電性インクパ

層を該バターンの膜厚より大なる状態で前面に設け、そ の後、該層が設けられている透明基体の裏側から該導電 性インクパターンをマスクにして前面露光する工程にお いては、通常は該フォトレジストの分光感度が近紫外領 域にあるので、従来公知の紫外線露光装置を使用すると とが出来る。又、導電性インクパターンのマスク性能に 関しては、一般に光学濃度が3.0以上あれば十分であ るが金属系導電性インクであれ、カーボン系の非金属導 電性インクであれ、膜厚が 1μ m以上であれば十分に条 件を満たす。特にカーボン系導電性インクを使用する場 合には、その効果は顕著である。また、本発明の場合、 前述したごとくマスクとレジストは隙間なく完全に密着 されている状態であるから解像性の観点においても有利 である。

【0034】該導電性インクバターン部上の未硬化のレ ジストの除去に関しては、前述したごとく有機溶剤でも アルカリ水でもよいが、特に環境およびコストの観点か ら炭酸ソーダなどのアルカリ水で現像し、該未硬化のレ ジストを除去することが好ましい。

【0035】光硬化したレジストをメッキレジストとし て、導電性インクバターン部上に電解メッキ法により、 銅、ニッケル、銀、金、半田、あるいは銅/ニッケルの 多層、あるいは複合系などの金属メッキをおとなう方法 は従来からの公知の方法を使用出来、これらに関しては 種々の成書がある。(例えば、「表面処理技術総覧」

(株)技術資料センター、1987/12/21初版、 P281~422) どの金属を電解メッキにより設ける かは、本発明を何に利用するかによりことなるが、例え ば、電磁波シールド部材として本発明を利用する場合に は、メッキが容易で、且つ導電性が優れ、さらに厚膜に もメッキでき、低コスト等の理由により、銅を用いる事 がこのましい。電解メッキの一例を挙げて説明すると、 硫酸銅、硫酸等を主成分とする浴中に該基体を浸潰し、 10~40℃で、電流密度1~20アンペア/dm²で 通電することによりメッキがおこなわれる。

【0036】本発明においては、フォトリソグラフィー 法により形成された耐メッキレジストをもとに導電性イ ンクパターン上にのみ金属メッキをすることにより、厚 膜の金属バターンにおいても、バターンプロファイルは 非常に良好である。

【0037】本発明の金属パターン形成方法を電磁波シ ールド部材として利用する場合には、このまま使用して もよいし、保護膜を設けて使用してもよい。又、必要に 応じて熱線カット機能層等の他の機能を有する透明基板 (あるいはフイルム)と接着剤を介して貼り合わせても よい。その場合には必要に応じて、該部材の透明フイル ムの表面処理等により密着性をコントロールし転写剥離 感材としてもよい。

【0038】本発明のメッシュバターンは、レジスト材。 ターンを設け、その上に光硬化タイプのフォトレジスト 50 で埋め込まれている状態で使用できるため、透明性や鮮

明性に優れた性能を発揮できる。

[0039]

【実施例】以下、本発明を実施例にもとずいて説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0040】実施例1

ポリエステル樹脂(東洋紡K. K. 製、商品名:バイロ ン300) 10.0重量部、をトルエン80重量部から なる溶剤に溶解させ、ついでグラフィト((株)中越黒 鉛工業所製、商品名: CPB-30) 8. 0重量部とケ ッチェンブラックEC (ライオン (株) 製) 3. 0重量 10 部を添加し、さらに混合した。得られた混合物を2mm Φジルコニアビーズを用いペイントシェーカーで10時 間分散し、導電性インク組成物を得た。このインク組成 物を適宜トルエンで希釈し、グラビア印刷法により、密 着改良を目的にグロー処理を施した、厚み100μmの ポリエステルフイルム上に、ライン巾20μm、ライン ピッチ250μm、インク乾膜厚2.5μmのメッシュ パターンを印刷した。その後、遠赤外線装置により10 分間熱キュアした。得られた導電性インクのベタ部にお ける体積固有抵抗は2.0×10⁻²Ωcmで表面抵抗 20 は3. 5×10° Q/□であった。又、光学濃度は4. 5以上であった。次に、とのメッシュパターン上に、プ リント配線基板作製用感光性ドライフイルムとして市販 されている、アルカリ現像(炭酸ソーダ水)タイプの耐 メッキレジスト用感光性ドライフイルムレジストフイル ム (レジスト膜厚約15μm)をカバーフィルムを剥が した後、真空ラミネータにより密着良くラミネートし *

*た。次に、前記ポリエステルフイルムの裏面から、導電 性インクメッシュパターンをマスクにして、紫外線を全 面に照射し、該メッシュパターンがない感光層のみを光 硬化させた後、所定の炭酸ソーダ水現像液により、メッ シュパターン上の感光層を除去した。次に、電解銅メッ キ用処理液(硫酸銅75g/1、硫酸190g/1、塩 素イオン50ppm、及びメルテックス社製カバークリ ームPCM5m1/1)を用い、所定の方法(25℃、 5 A/c m²) に従って、レジスト開口部である、導電 性インクメッシュバターン上にのみに膜厚12μmの銅 メッキを施した。次に、該フイルムの銅メッキされた面 を、光硬化したレジストでと、アクリル系接着剤を介し て(膜厚8μm)透明アクリル基板と接着させた。得ら れた透明電磁波シールド部材のシールド性は1~1、0 00MHzの周波数の範囲に亘って50dB、可視光透 過率71%を達成した。

[0041]

【発明の効果】上記の説明から明らかなように、本発明の方法により、PDP用前面フィルターとして高性能な透明電磁波シールド部材を簡便に生産性良く作製することが出来る。更に本発明よる電磁波シールド部材は建築物の電磁波障害防止のために窓ガラス等への適用にも有効である。更に本発明は電磁波シールド部材の作製を例に主として説明したが、本発明の金属パターン形成方法は、電磁波シールド部材作製用のみならず、各種の金属配線パターン形成等への展開も可能となる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

H01J 11/02 H05K 9/00

H01J 11/02 H05K 9/00

FΙ

デマント (参考) Z 5C040 V 5E321

F ターム (参考) 2H025 AA00 AA02 AB17 AB20 AC01 AD01 DA18 EA04 EA08 FA01 FA03 FA17 FA43 2H096 AA00 AA27 BA05 CA12 CA16 EA02 EA16 GA08 HA27 JA04 4J038 NA19 NA20 PB05 PB09 4K024 AA09 AB08 BA12 BB09 DA10 FA05 5C028 AA01 AA10 5C040 FA01 FA02 GA02 GH10 JA08

> MA08 MA22 MA26 5E321 AA04 BB23 BB41 GG05 GH01